

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Максименко Юрия Николаевича на тему:
 “Мощные полупроводниковые приборы со статической индукцией”
 по специальности 2.2.2. - «Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники,
 квантовых устройств»
 на соискание ученой степени доктора технических наук

Ф.И.О. полностью	Наумова Ольга Викторовна
Гражданство	РФ
Ученая степень	Доктор физико-математических наук
Шифр и название специальности по которой защищена диссертация оппонента, отрасль науки	Специальность 01.04.10-физика полупроводников
Ученое звание	Доцент
Основное место работы:	
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова» Сибирского отделения Российской академии наук
Сокращенное наименование организации	ИФП СО РАН
Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования РФ
Почтовый адрес организации	630090, Россия, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 13.
Телефон, факс, e-mail организации	Тел: +7(383)330-90-55, факс: +7(383)333-27-71. E-mail: ifp@isp.nsc.ru
Наименование подразделения организации	Лаборатория технологии кремниевой микроэлектроники
Должность в организации	Заведующий лабораторией

Список основных публикаций по теме оппонируемой диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1.	Nikulshin P.V., Makarov A.YU., Koskin I.P., Becker CH.S., Kazantsev M.S., Beckmann J., Balmohammadi YA., Grabowsky S., Mebs S., Naumova O.V., Protasov D.Yu., Svit K.A., Irtegova I.G., Radiush E.A., Bagryanskaya I.YU., Shundrin L.A., Zibarev A.V. 1,2,3,4-Tetrafluorobiphenylene: A Prototype Janus-Headed Scaffold for Ambipolar Materials. ChemPlusChem, 2024, v.89, №5, p. e202300692
2.	О.В. Наумова, А.В. Царев, Э.Г. Зайцева., А.Ю.Петин, Ю.А.Живодков, С.А.Пономарев, А.С. Ярошевич. Чёрный Al на SiON, полученный методом магнетронного распыления. Автометрия, 2024, 60, №4, стр. 20-25
3.	A. Bulgakova, A. Berdyugin, O. Naumova, B. Fomin, D. Pyshnyi, A. Chubarov, E. Dmitrienko, A. Lomzov. Solution pH Effect on Drain-Gate Characteristics of SOI FET Biosensor. Electronics, 2023, v.12, №3, p. 777
4.	Naumova O., Generalov V., Shcherbakov D., Zaitseva E., Zhivodkov Yu., Kozhukhov A., Latyshev A., Aseev A., Safatov A., Buryak G., Cheremiskina A., Merkuleva J., Rudometova N. SOI-FET Sensors with Dielectrophoretic

	Concentration of Viruses and Proteins. Biosensors-Basel, 2022, v.12, №11, p. 992
5.	Zaytseva E.G., Naumova O.V., Gutakovskii A.K. Conditions for the identical distribution of free carriers in thin films. Journal of Physics D: Applied Physics, 2022, v.55, №7, p. 075101
6.	Naumova O.V., Zaytseva E.G. Analysis of Electric Field Distribution for SOI-FET Sensors with Dielectrophoretic Control. Sensors, 2022, v.22, №7, p. 2460
7.	Zaytseva E.G., Naumova O.V., Gutakovskii A.K. Extraction of the components of effective mobility in thin films. Journal of Physics D: Applied Physics, 2021, v.54, №25, p. 255105
8.	Дмитриенко Е.В., Порываева А.В., Наумова О.В., Фомин Б.И., Купрюшкин М.С., Пышная И.А., Пышный Д.В. Валидация гетерофазного анализа РНК с помощью КНИ-биосенсора Автометрия, 2021, т.1, стр. 50-56
9.	В.М.Генералов, О.В.Наумова, С.А. Пьянков, И.В.Колосова, А.С. Сафатов, Э.Г. Зайцева, Г.А. Буряк, А.А. Черемискина, Н.А.Филатова, А.Л.Асеев. Индикация вируса осповакцины с помощью нанопроволочного кн-биосенсора. Автометрия, 2021, т.1, стр. 42-49
10.	О.В.Наумова, В.М.Генералов, Э.Г. Зайцева, А.В.Латышев, А.Л. Асеев, С.А Пьянков., И.В. Колосова, Г.Г. Ананько, А.П. Агафонов, Е.В. Гаврилова, Р.А. Максютон, А.С. Сафатов. Биосенсоры на основе КНИ-нанопроволочных транзисторов для биомедицины и вирусологии Микроэлектроника, 2021, т.50, №3, стр. 166-174
11.	А.М.Никонов, О.В.Наумова, В.М.Генералов, А.С.Сафатов, Б.И. Фомин. Подготовка поверхности нанопроволочных кремниевых полевых транзисторов как этап создания биосенсора: обзор. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2020, т.4, стр. 24-34
12.	Зайцева Э.Г., Наумова О.В., Фомин Б.И. Профилирование компонент подвижности вблизи гетерограниц тонких пленок кремния. Физика и техника полупроводников, 2020, т.54, №2, стр. 124-128

«23» января 2025 г.

Сведения (по
Ученый секр

____ / Наумова Ольга Викторовна

Аржанникова София Андреевна

«23» января 2025 г.